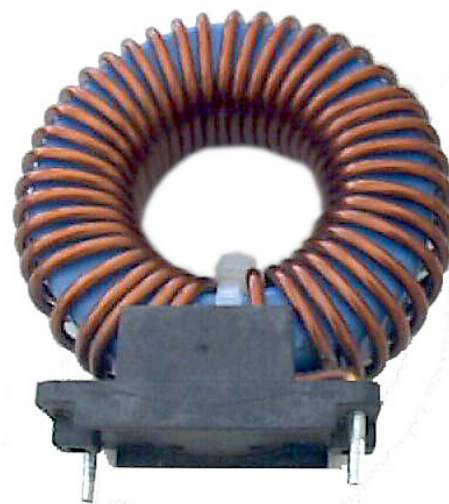


**Speicherdrosseln
mit KoolM μ -Ringkern**

**Baureihe CHI 210
Type CHI 212 B/..
Type CHI 212 G/..**

Anwendungen:

In getakteten Netzteilen mit hohen Taktfrequenzen, überall, wo hohe Strombelastung bei kleinen Verlusten gefordert wird.



Nennspannung 250 V~	Betriebstemperatur -40 °C...+125 °C
Prüfspannung/Test voltage/Tension d'essai (ohne)	Geprüft nach EN 138000
Nenninduktivität +20% -20% bei 10 kHz	Bauform Offen, stehend + gesockelt, PIN-Raster

Vorteile:

- Hohe Sättigungsinduktion
- Hohes Speichervermögen
- Hohe Taktfrequenz bis 150kHz
- Betriebstemperatur max. 125 °C
- Geringe Verluste
- Minimale Streuinduktivität
- Minimales magnetisches Streufeld
- Geringer Platzbedarf
- Nach UL 94 V-0

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

Brühler Strasse 100
D-42657 Solingen
Tel. 0049-(0) 2 12-88 04-0
Fax 0049-(0) 2 12-8804-188
www.reo.de
email: main@reo.de

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

Setzermann Division
Schuldhölzinger Weg 7
D-84347 Pfarrkirchen
Tel. 0049-(0) 85 61-63 06
Fax 0049-(0) 85 61-52 10
www.reo.de
email: setzermann@reo.de

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

IBK Division
Holzhausener Strasse 52
D-16866 Kyritz
Tel. 0049-(0) 3 39 71-4 85-0
Fax 0049-(0) 3 39 71-4 85-88
www.reo.de
email: ibk@reo.de

Technische Daten

Type	BV-Nr	Nenn-induktivität L_N (mH) je Wicklung	Nenn-strom I_N (A)	Gleichstrom-widerstand R_{Cu} (m Ω) je Wicklung
CHI 212 B/2/1	942780	1	2	180
CHI 212 B/3,5/1,3	942781	1,3	3,5	110
CHI 212 B/5/1	942782	1	5	73
CHI 212 B/6/1	942783	1	6	65
CHI 212 B/7/0,6	942784	0,6	7	37
CHI 212 B/8/0,8	942785	0,8	8	48
CHI 212 B/10/0,15	942786	0,15	10	10
CHI 212 B/15/0,025	942787	0,025	15	3,5
CHI 212 B/20/0,055	942788	0,055	20	5
CHI 212 G/2/1	942770	1	2	180
CHI 212 G/3,5/1,3	942771	1,3	3,5	110
CHI 212 G/5/1	942772	1	5	73
CHI 212 G/6/1	942773	1	6	65
CHI 212 G/7/0,6	942774	0,6	7	37
CHI 212 G/8/0,8	942775	0,8	8	48
CHI 212 G/10/0,15	942776	0,15	10	10
CHI 212 G/15/0,025	942777	0,025	15	3,5
CHI 212 G/20/0,055	942778	0,055	20	5

Frequenz bis 150 kHz

Frequency up to 150 kHz

Fréquence jusqu'à 150 kHz

Schaltung

I



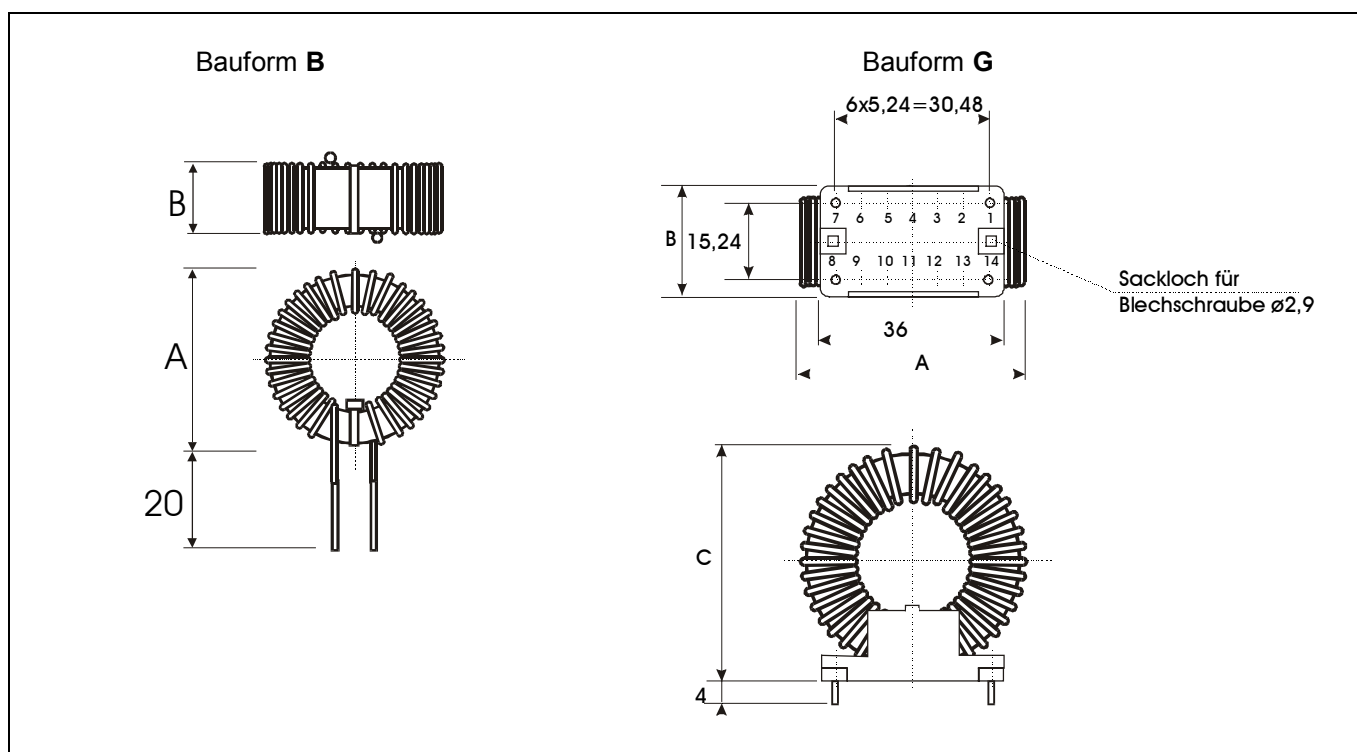
II



III



Maßbild

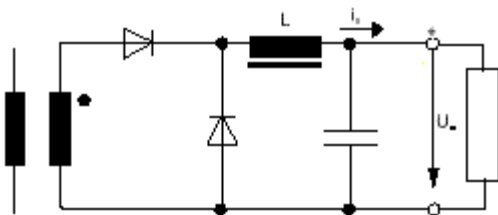


Type	BV-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PIN-Belegung	Schaltung
CHI 212 B/2/1	942780	33	16	-	-	I
CHI 212 B/3,5/1,3	942781	41	17	-	-	I
CHI 212 B/5/1	942782	45	18	-	-	I
CHI 212 B/6/1	942783	45	18	-	-	I
CHI 212 B/7/0,6	942784	44	18	-	-	II
CHI 212 B/8/0,8	942785	57	20	-	-	II
CHI 212 B/10/0,15	942786	44	18	-	-	II
CHI 212 B/15/0,025	942787	36	16	-	-	II
CHI 212 B/20/0,055	942788	43	18	-	-	III
CHI 212 G/2/1	942770	33	22	36	7 - 14	I
CHI 212 G/3,5/1,3	942771	41	22	44	7 - 14	I
CHI 212 G/5/1	942772	45	22	47	7 - 14	I
CHI 212 G/6/1	942773	45	22	47	7 - 14	I
CHI 212 G/7/0,6	942774	44	22	46	1,14 - 7,8	II
CHI 212 G/8/0,8	942775	57	22	59	1,14 - 7,8	II
CHI 212 G/10/0,15	942776	44	22	46	6 - 13	II
CHI 212 G/15/0,025	942777	36	22	36	2,6 - 9,13	II
CHI 212 G/20/0,055	942778	43	22	45	1,2,6,7 - 8,9,13,14	III

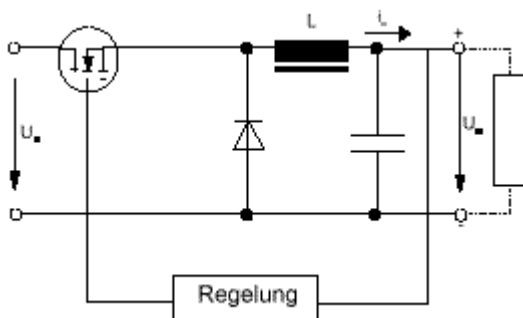
Speicher- und Siebdrosseln

Grundlagen

In Schaltnetzteilen, die nach dem Durchflußwandlerprinzip arbeiten, sowie in getakteten Längsreglern, werden lineare Speicherdrosseln eingesetzt. Deren Aufgabe ist es, den pulsierenden Gleichstrom zu glätten, indem sie Energie während der Stromflußzeit speichern und in den Pausen den Stromfluß im Lastkreis aufrecht erhalten. Erforderlich sind Induktivitäten mit hoher Gleichstromvorbelastbarkeit. Speicherdrosseln in modernen Stromversorgungen müssen daher hohen Anforderungen gerecht werden, wie beispielsweise hohe Speicherenergie in kleinem Bauvolumen und geringe Verluste bei hohen Taktfrequenzen. Ferner wird ein kostengünstiger Aufbau gefordert.



Speicherdrossel im Ausgangskreis eines Durchflußwandlers



Speicherdrossel L in einem Schaltregler

Gleichstromvorbelastung

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den typischen normierten Verlauf der Induktivität L über der Gleichstromvorbelastung I bei Raumtemperatur.

